PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-302572

(43) Date of publication of application: 28.10.1994

(51)Int.CI.

H01L 21/304

H01L 21/304

H01L 21/66

H01L 21/68 H01L 21/78

(21)Application number: 05-084217

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

12.04.1993

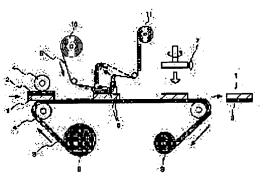
(72)Inventor: ABE YOSHIYUKI

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE AND TAPE ADHERING AND PEELING APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate a crack of a wafer due to vibration and impact during conveying of the wafer, removal from a wafer cassette, etc., by grinding a rear surface of the wafer, then adhering a reinforcing tape to the rear surface of the wafer, and peeling a protective tape adhered to an element forming surface.

CONSTITUTION: A wafer 1 adhered with a protective tape 2 is inserted into an adhering roller 4, a reinforcing tape 3 fed from a reinforcing tape roll 8 is adhered to a rear surface of the wafer 1 by the roller 4. Then, a peeling tape 5 fed from a peeling tape roll 10 is adhered to the tape 2 by a peeling roller 6, the tape 5 is peeled from the wafer 1, and the tape 5 is wound by a peeling tape winding roll 11. Thereafter, the tape 3 is cut by a cutter 7 to match a shape of the wafer 1. Then, a residue of the tape 3 cut by the cutter 7 is wound by a reinforcing tape winding roll 9. Thus, the tape 3 is adhered to hold a strength of the wafer 1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

THIS PAGE BLANK (USP 10)

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-302572

(43)公開日 平成6年(1994)10月28日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FI				技術表示箇所	
H01L 21/304	3 3 1	8832-4M		•				
	3 2 1 B	8832-4M						
21/66	В	7630-4M	•				•	
21/68	Α	8418-4M						
21/78	M	8617-4M						
		審査請求	未請求	請求項の数 2	OL	(全 5 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号 特顧平5-84217				(71)出願人 000005108				

. (22)出願日

平成5年(1993)4月12日

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 阿部 由之

東京都小平市上水本町5丁目20番1号 株

式会社日立製作所半導体事業部内

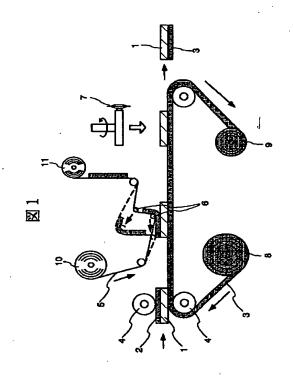
(74)代理人 弁理士 秋田 収喜

(54)【発明の名称】 半導体装置の製造方法及びテーブ貼付剝離装置

(57)【要約】

【目的】 半導体装置の歩留りを向上し、半導体装置の 製造時間を短縮する。

【構成】 半導体基板1の一主面に素子形成し、主面に保護テープ2を貼り、反対の主面(裏面)を研削し、保護テープ2を剥離し、プローブをあて特性検査をし、ペレット分離する半導体装置の製造方法において、研削の後に、裏面に補強テープ3を貼付け、補強テープ3を貼付けた後、保護テープ2を剥離する。また、テープ貼付剥離装置にあっては、一主面に保護テープ2が貼付けられた半導体基板1の、反対の主面に補強テープ3を貼付ける補強テープ貼付手段と、保護テープ2を半導体基板1から剥離する保護テープ剥離手段と、前記補強テープ3を半導体基板1の形状に合わせて切り取る補強テープ切断手段とを有する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板の一主面に素子を形成し、その一主面に第1テープを貼り、その一主面とは反対の主面(裏面)を研削し、前記一主面に貼付けられた第1テープを剥離し、前記一主面にプローブをあて特性を検査し、ベレット分離する半導体装置の製造方法において、前記研削の後に、前記裏面に第2テープを貼付け、該第2テープを貼付けた後、前記第1テープを剥離することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】 一主面に第1テープが貼付けられた半導 10 体基板の、その一主面とは反対の主面に第2テープを貼付ける第2テープ貼付手段と、前記第1テープを前記半導体基板から剥離する第1テープ剥離手段と、前記第2テープを半導体基板の形状に合わせて切り取る第2テープ切断手段とを有することを特徴とするテープ貼付剥離装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置の製造方法 において、厚さが薄く、面積の大きい半導体基板を使用 する半導体装置の製造方法に適用して有効な技術に関す る。

[0002]

【従来の技術】半導体装置のバッケージは薄型化の傾向にあり、パッケージの厚さが薄くなるのに伴い、半導体ベレットの厚さも薄型化が要求されている。例えば、バッケージの厚さが1000μmの場合、リードフレームの厚さ、ワイヤボンディングの高さ、モールド樹脂の封止性及び遮光性等から、半導体ベレットは250μm程度まで薄くする必要がある。

【0003】また、半導体装置の生産性向上のため、半 導体基板(シリコンウエハ、以下ウエハと記す)の面積 は大きくなり、例えば、直径 φ200 mmのウエハを使 用している。また更に、大面積のウエハを検討してい る。

【0004】また、半導体装置の製造プロセスにおいて、素子を形成したウェハの一主面(以下、素子形成面)とは反対の主面(以下、裏面と記す)は、素子形成時に生成された酸化珪素膜を取り除くとともに、ウェハの厚さ(例えば650μm~750μm)をベレットの厚さ(例えば250μm程度)に薄くするために、裏面を研削している。該研削時には、素子形成面には、保護のため片面に粘着性のある保護テープを貼り付けている。また、該研削は、冷却水として純水を供給しながら、砥石でウェハ裏面を削り取ることにより行われる。次に、ウェハ裏面研削を終了したウェハに貼付られた保護テーブを剥がし、ウェハカセットに収納し、ウェハブローブ検査工程に搬送する。

【0005】ウエハブローブ検査工程は、ウエハをウエ 発明のうち、代表的なハカセットから取りだし、検査プローブを前記半導体ウ 50 下記のとおりである。

エハの表面に形成した電極にあて、素子の特性を検査 し、不良ペレットには印をつけ、再び、ウエハカセット に収納し、その後、ペレット分離工程に搬送する。

【0006】ベレット分離は、半導体ウェハをウェハカセットから取り出し、粘着性及び伸展性を有するダイシングテーブをウェハの裏面に貼付け、ダイシング及びブレーキングを行い、前記ダイシングテーブをエキスパンド(引き延ばし)し、ベレット分離する。そして、引き続き、マウント工程、ボンディング工程、封止工程、マーキング工程を行い。半導体装置が完成する。

【0007】また、ウエハの素子形成面(または裏面)へのテープの貼付けはテープ貼付装置により行っている。テープ貼付け装置とは、試料台の上に、テープを貼付ける面が上になるようにウエハを乗せ、ウエハの素子形成面(または裏面)にテープをローラで圧着し、テープをカッタでウエハの形状に合わせて、切断することによりテープをウエハに貼付ける装置である。

【0008】また、ウエハ主面に貼付けたテープの剥離は、テープ剥離装置により行っている。テープ剥離装置とは、前記テープが上になるように前記ウエハを乗せ、前記テープに、該テープよりも粘着力の強い剥離テープをローラで貼付けるとともに、引き剥がすことによりテープをウエハから剥離する装置である。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、本発明 者は前記従来技術を検討した結果、以下の問題点がある ととを見出した。

【0010】従来、半導体装置の製造工程において、裏面研削後のウエハは、ウエハカセットに収納され、各工 程間を搬送される。この時、ウエハは厚さが250μm であるのに対し、ウエハの直径がφ200mmである。つまり、ウエハは厚さが薄く面積が大きいため、強度が弱くなっているので、ウエハは非常に割れやすい状態にある。このため、搬送中の振動及び衝撃や、各工程でのウエハカセットからの取り出し及び収納等により、ウエハが割れる。割れたウエハは、ウエハカセットに収納できず、後の工程を流せなくなり、半導体装置の歩留まりが低下する。

【0011】本発明の目的は、半導体装置の歩留りの向上が可能な技術を提供することにある。

【0012】本発明の他の目的は、半導体装置のダイシングテープを貼付けることを省略することが可能な技術を提供することにある。

【0013】本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らかになるであろう。

[0014]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 下記のとおりである

!

30

【0015】半導体基板の一主面に素子形成し、その一 主面に保護テープを貼り、その一主面とは反対の主面 (裏面)を研削し、前記一主面に貼付けられた保護テー ブを剥離し、前記一主面にプローブをあて特性検査を し、ペレット分離する半導体装置の製造方法において、 前記研削の後に、前記裏面に補強テープを貼付け、該補 強テープ貼付けた後、前記保護テープを剥離する。

【0016】また、テーブ貼付剥離装置にあっては、一 主面に保護テープが貼付けられた半導体基板の、その一 主面とは反対の主面に補強テープを貼付ける補強テープ 10 貼付手段と、前記保護テープを前記半導体基板から剥離 する保護テープ剥離手段と、前記補強テープを半導体基 板の形状に合わせて切り取る補強テープ切断手段とを有 する。

[0017]

【作用】上述した半導体製造方法は、ウェハの裏面を研 削した後、ウエハに強度を持たせるために補強テープを ウエハ裏面に貼付け、該補強テープ貼付けた後、素子形 が成面に貼付けた保護テープの剥離を行うため、ウエハの 厚さが薄くて面積が大きくても、ウエハの強度が保たれ 20 る。これにより、搬送中の振動及び衝撃や、各工程での ウエハカセットからの取り出し及び収納等による、ウエ ハの割れが解消できる。とのため、ウエハの割れによる 不良が無くなる。との結果、半導体装置の歩留まりを向 上することができる。

【0018】また、補強テープは、ダイシング時にウエ ハの裏面に貼付けるダイシングテープの替わりとしても 使用でき、かつ、補強テーブは、保護テーブの剥離と同 時に貼付けるので、ダイシングテープを貼付ける工程を 省略することができる。この結果、半導体装置の製造時 間を短縮できる。

【0019】また、上述したテープ貼付剥離装置は、ウ エハの裏面に補強テープを貼付け、素子形成面に貼付け られた保護テープを剥離し、補強テープをウエハに沿っ て切り取るので、ウエハ裏面への補強テープの貼付け と、保護テープの剥離とを同時に行うことができる。こ れにより、この装置で処理されたウエハは、補強テープ により強度が保たれる。このため、ウエハの割れによる 不良が低減できる。この結果、半導体装置の歩留まりを 向上することができる。

[0020]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例につい て詳細に説明する。なお、実施例を説明するための全図 において、同一機能を有するものは同一符号を付け、繰 り返しの説明は省略する。

【0021】図1は、本発明によるテープ貼付剥離装置 の一実施例の概略構成を示す模式構成図である。1は一 主面に素子が形成された半導体基板(以下、ウェハと記 す)、2はウエハ1の裏面研削時に素子形成面を保護す るため、素子形成面に貼付けられた保護テープ、3はウ 50 エハの形状に合わせて切断することによりウエハ主面に

エハ1の強度を保つため、ウエハ1の裏面に貼付ける補 強テープ、4はウエハ1の裏面に補強テープ3を貼付け るための貼付ローラ、5はウエハ1から保護テープ2を 剥離するための剥離テープ、6は剥離テープ5を保護テ ープ2に貼付けるとともに、ウエハ1から保護テープ5 を剥離する剥離ローラ、7は補強テープ3をウエハ1に 沿って切断するためのカッタ、8は補強テープを供給す るための補強テープロール、9はカッタ7で切断した補 強テープ3の残りを巻き取るための補強テープ巻き取り ロール、10は剥離テープを供給するするための剥離テ ープロール、11は剥離テープを巻き取るための剥離テ ープ巻き取りロールである。

【0022】本実施例のテーブ貼付剥離装置の動作は、 保護テープ2が貼付けられたウエハ1を貼付ローラ4に 挿入し、補強テープロール8から送られてきた補強テー プ3を、貼付ローラ4でウエハ1の裏面に貼付ける。 【0023】次に、剥離テープロール10から送られて きた剥離テープ5を、剥離ローラ6で、保護テープ2に 貼付けるとともに、ウエハ1から保護テープ5を剥離 し、剥離テープ5は剥離テープ巻き取りロール11で巻

【0024】次に、補強テープ3はウエハ1の形状に合 わせてカッタ7により切断される。

【0025】次に、カッタ7で切断された補強テープ3 の残りは、補強テープ巻き取りロール11で、巻き取ら れる。これにより、補強テープ3を貼付けることにより によりウエハ1の強度が保たれる。

【0026】以上の説明からわかるように、本実施例に よれば、ウエハ裏面への補強テープの貼付けと、保護テ ープの剥離を同時に行うことができる。これにより、こ の装置で処理されたウエハは、補強テーブを貼付けると とにより強度が保たれる。このため、ウエハの割れによ る不良が低減できる。この結果、半導体装置の歩留まり を向上することができる。

【0027】図2は、本発明による半導体装置の製造方 法の一実施例を示すフローチャートである。 本実施例の 半導体装置の製造方法を図2にそって説明する。

【0028】(201)素子形成。

まず、半導体基板(シリコンウエハ、以下、ウエハと記 40 す)の一主面に素子を形成する。該ウエハは、例えば直 ・径がφ200mm~φ300mmであり、厚さが650 μ m \sim 750 μ m σ a3.

【0029】(202)保護テープ貼付。

次に、前記素子形成面に保護テープを貼付ける。保護テ ープ貼付は、裏面研削時に素子形成面を研磨液等から保 護するために行う。また、テープの貼付けは、テープ貼 付装置により行う。テープ貼付装置は、試料台の上にテ ープを貼付ける主面が上になるようにウエハを乗せ、該 主面にテープをローラで圧着し、該テープをカッタでウ

5

テープを貼付ける。

【0030】(203)裏面研削。

次に、前記ウエハ裏面を研削する。裏面研削はウエハの厚さ(例えば 650μ m $\sim750\mu$ m)をベレットの厚さ(例えば 400μ m $\sim200\mu$ m)まで薄くするために行う。研削は、研磨材(酸化アルミニウム等の粉末)を含む研磨液を供給しながら、砥石でウエハ裏面を削り取ることにより行われる。

【0031】(204)補強テープ貼付。

次に、裏面に補強テーブを貼付け、素子形成面の保護テ 10 ープを剥離する。補強テーブ貼付は、ウエハに強度を持たせるために行う。保護テーブはウエハブローブ検査を行うために剥離する。該補強テーブ貼付及び該保護テープ剥離は、前述テーブ貼付剥離装置により行う。補強テーブは、厚さ100μm程度で、片面に粘着性がある粘着シートである。

【0032】(205) ウエハブローブ検査。

次に、ウエハプローブ検査を行う。ウエハプローブ検査 とは、ウエハの前記素子形成面に設けられた電極にプロ ーブをあて、素子特性を検査し、不良ペレットに印をつ 20 け、選別するための検査である。

【0033】(206)ペレット分離。

次に、ウエハをペレットに分離する。ペレット分離は、 ダイシング装置のダイシングブレードを高速で回転さ せ、ウエハのペレット間に前記ダイシングブレードで任 意の深さまで切断し、該ウエハにローラで応力を加え て、ペレットに分離する工程である。

【0034】(207)組立て工程。

次に、半導体装置の組立てを行う。保護テープの下面からニードルで突き上げてベレットを取り、リードフレー 30 ムにマウントし、金属ワイヤでベレットの電極とリードフレームのリードとをボンディングし、エポキシ系の樹脂で封止し、マーキングを施して半導体装置が完成する。

【0035】以上の説明からわかるように、本実施例に よれば、ウエハの裏面を研削した後、ウエハに強度を持 たせるために補強テープをウエハ裏面に貼付け、該補強テーブ貼付け後、素子形成面に貼付けた保護テープの剥離を行うため、ウエハの厚さが薄くて面積が大きくても、ウエハの強度が保たれる。これにより、搬送中の振動及び衝撃や、各工程でのウエハカセットからの取り出し及び収納等による、ウエハの割れが解消できる。このため、ウエハの割れによる不良が無くなる。この結果、半導体装置の歩留まりを向上することができる。

【0036】また、補強テーブは、ダイシング時にウェハの裏面に貼付けるダイシングテープの替わりとしても使用でき、かつ、補強テーブは、保護テープの剥離と同時に貼付けるので、ダイシングテープを貼付ける工程を省略することができる。この結果、半導体装置の製造時間を短縮できる。

[0037]以上発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

[0038]

) 【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表 的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下 記のとおりである。

【0039】1. 半導体装置の歩留りを向上できる。

【0040】2. 半導体装置の製造時間を短縮できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明によるテーブ貼付剥離装置の一実施例の概略構成を示す模式構成図、

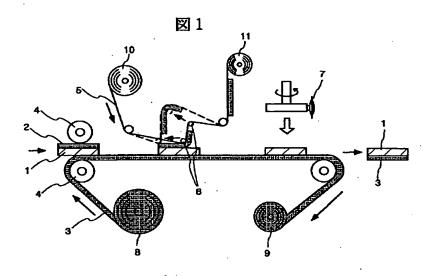
【図2】 本発明による半導体装置の製造方法の一実施例を示すフローチャート。

30 【符号の説明】

1…ウエハ、2…保護テーブ、3…補強テープ、4…貼付ローラ、5…剥離テープ、6…剥離ローラ、7…カッタ、8…補強テープロール、9…補強テープ巻き取りロール、10…剥離テープ、11…剥離テープ巻き取りロール。

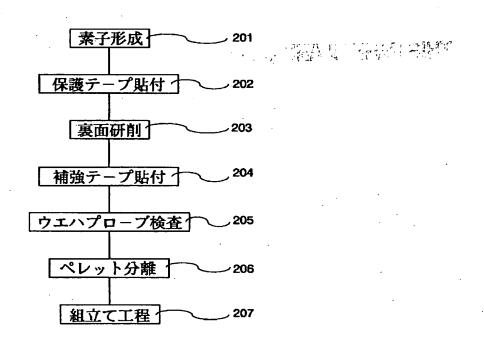
6

【図1】



【図2】

図2



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁵ HOlL 21/78 識別記号 庁内整理番号P 8617-4M

FΙ

技術表示箇所

THIS PAGE BLANK (USPTO)